

- ◆ Automotive Product Catalogue
- ◆ MOSFETs Product Catalogue
- ◆ IGBT/Power Module Product Catalogue
- ◆ SiC Product Catalogue
- ◆ Diode & BJT Product Catalogue

扬州扬杰电子科技股份有限公司
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

地址：中国扬州市邗江区荷叶西路6号
电话：4001060780
邮件：yangjie@21yangjie.com
网址：www.21yangjie.com



2023年09月第一版

SiC PRODUCT CATALOGUE

SiC 产品手册

20⁺ 年来的发展历程和突破

中国功率器件前三强企业

中国极少数深度垂直一体化全产业链（IDM）企业

全球功率分立器件行业 TOP12, 细分市场行业 TOP1

公司简介 Company Profile

公司名称	扬州扬杰电子科技股份有限公司	总部所在地	扬州市邗江区荷叶西路6号
成立时间	2000年	注册资本	51240.0109万元整
上市时间	2014年1月23日（深交所）	股票代码	300373
主营产品	MOSFET、IGBT、SiC、整流器件、保护器件、小信号、WAFER、硅片、外延片		



公司沿革 Milestone

2000年	扬杰成立，开启YJ民族工业企业成长之路	2006年	设立第一个封装工厂，成功从贸易走上了产销研一体化之路
2009年	设立GPP晶圆FAB，成为集芯片设计、晶圆制造、封装测试、销售服务为一体的分立器件IDM企业	2012年	300373成功登录创业板 设立汽车芯片工厂 成立台湾办事处
2015年	设立6寸晶圆FAB 全资收购MCC 韩国办事处成立	2016年	成立低压MOS研发中心 成立碳化硅研发团队 大功率汽车电子芯片项目奠基
2017年	投资建设小信号封装产品线 收购成都青洋 成立汽车电子项目部	2018年	收购宜兴杰芯半导体 设立车用封装专线
2020年	设立扬州5号工厂，设立IGBT产线 收购菱芯，成立泗洪红芯 通过AEO认证	2021年	成立无锡MOS分公司 收购润奥、收购雅吉芯 CRM系统上线
2022年	收购杰楚微8寸晶圆FAB 设立台湾/日本研发中心 设立扬杰6号厂		

体系证书 System Certification

集团已经获得以下管理体系的认证

- ISO9001, IATF16949 质量管理体系
- ISO14001 环境管理体系；
- IECQ QC080000 有害物质管理体系
- ANSI/ESD S20.20 静电防护管理体系
- ISO27001 信息安全管理体系
- ISO17025 实验室管理体系认证（CNAS）
- SONY Green Partner



全产业链模式

全系列半导体分立器件产品解决方案

公司产品线含盖单晶硅棒、硅片、外延片、分立器件芯片、MOSFET、IGBT& 功率模块、SiC、整流器件、保护器件、小信号等，为客户提供一揽子产品解决方案。



国家高新技术企业



高品质



AECQ101



稳定供应

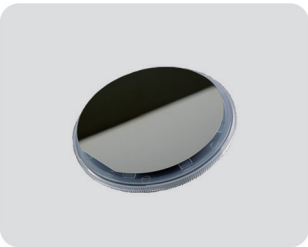
产品介绍 Product introduction



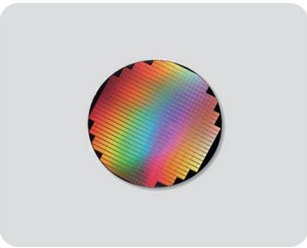
Silicon Ingot



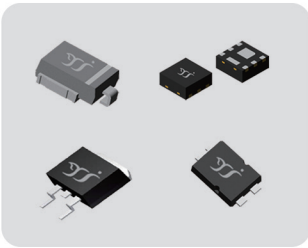
Silicon Wafer



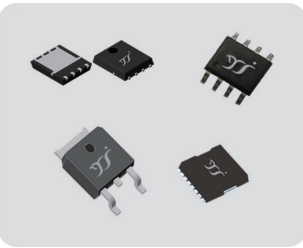
EPI Wafer



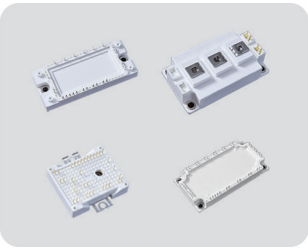
Wafer



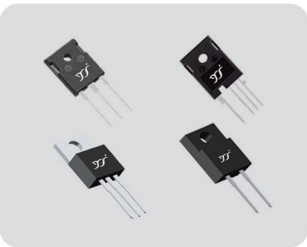
Automotive



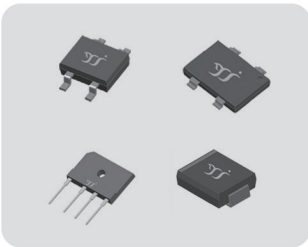
MOSFETs



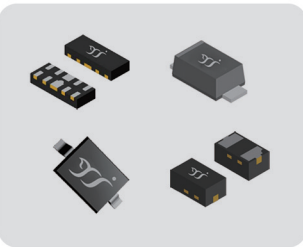
IGBT



SiC



Rectifier



Protection Diode



Small Signal

主要客户 Main Customers



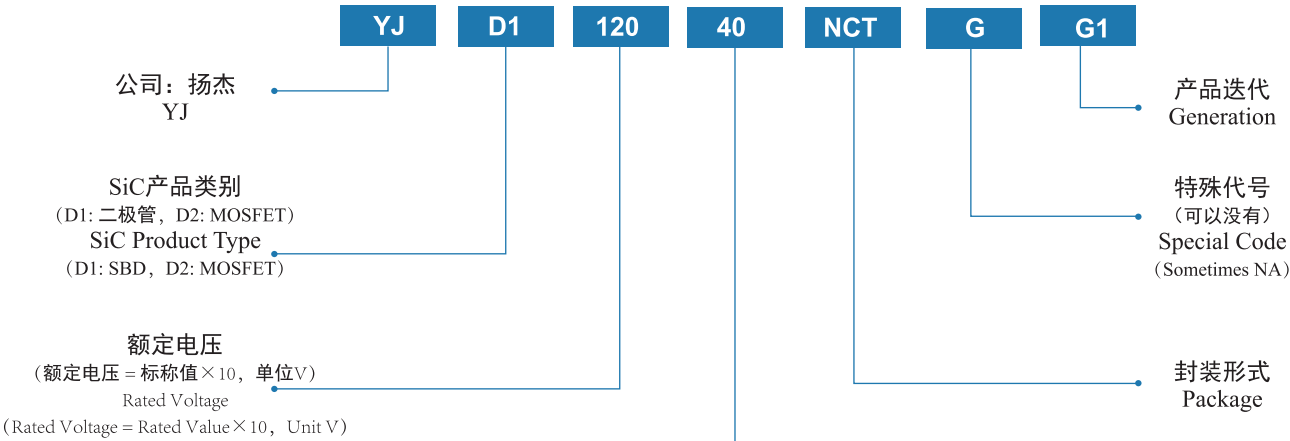
CATALOG ++

YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY

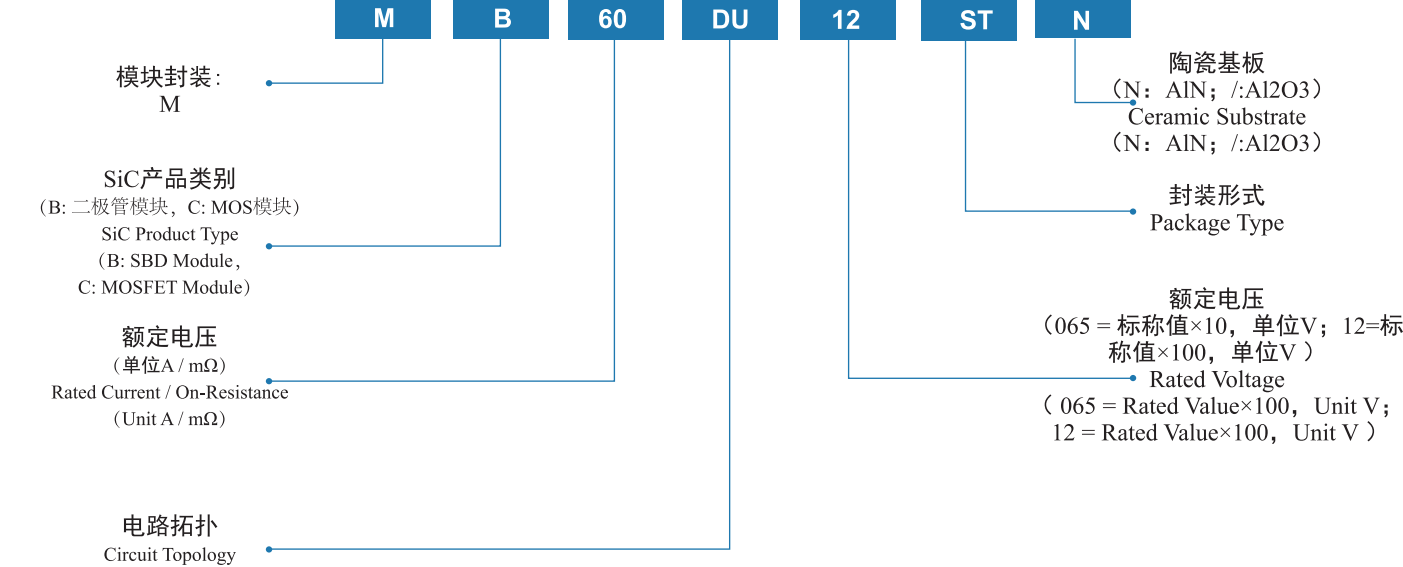
目录 >>

命名规则 NAMING RULES	1
包装形态 PACKING	1
SiC MOSFET 车规 SiC MOSFET AUTOMOTIVE	2
SiC MOSFET SiC MOSFET	3
SiC 肖特基二极管 SiC SBD	4-5
SiC MOSFET模块 SiC MOSFET MODULE	5
SiC SBD模块 SiC SBD MODULE	5
应用+产品推介 APPLICATION&PRODUCT INTRODUCTION	6-15
公司实验室平台 COMPANY LABORATORY PLATFORM	16
长期可靠性试验测试参考表 LONG TERM RELIABILITY TEST REFER	17
长期可靠性试验测试参考表-车用 LONG TERM RELIABILITY TEST REFER –AUTOMOTIVE	18
全球布局 GLOBAL LAYOUT	19

命名规则 NAMING RULES SiC DISCRETE



SiC MODULE



包装形态

PACKAGING

封装型号 Package No	包装代码 Packing Code	包装方式 Packing Method	PCS/(管or卷) Tube/Reel	只/盒 Pcs/Box	只/箱 Pcs/Carton	内盒尺寸 (mm) Inner Box Size			外箱尺寸 (mm) Carton Size			单盒重量 (±0.3Kg) Single box weight		整箱重量 (±0.5Kg) FCL weight	
						长 (L)	宽 (W)	高 (H)	长 (L)	宽 (W)	高 (H)	毛重 (KG)	净重 (KG)	毛重 (KG)	净重 (KG)
TO-220AC	B1	管装	50	1000	5000	550	155	38	570	210	175	2.69	1.85	13.90	9.25
ITO-220AC	B1	管装	50	1000	5000	550	155	38	570	210	175	2.29	1.45	11.90	7.25
TO-252	F1	卷装	2500	2500	25000	345	345	26	380	290	365	1.27	0.80	13.35	8.00
TO-263/D2PAK	F1	卷装	1000	2000	10000	400	390	70	430	410	375	3.91	2.70	20.50	13.50
TO-247	B1	管装	30	360	1800	520	115	60	550	325	135	2.86	2.23	14.98	11.16
SOT-227(塑封)	B1	管装	12	120	720	560	90	60	572	302	150	4.20	3.50	25.75	20.88
SOT-227(灌胶)	A2	盒装	/	25	125	290	252	50	300	270	280	0.152	0.125	5.4	5.37
34mm	A1	盒装	/	8	80	268	250	48	545	285	240	1.602	1.442	16.8	16.6

SiC MOSFET 车规
SiC MOSFET AUTOMOTIVE

SiC MOSFET AUTOMOTIVE										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25℃	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{tot} (W)	R _{thJC} (°C/W)	T _J (℃)	Package
YJD212030NCTGHQ	1200V	30 mΩ	GH	78	305	198	375	0.4	175	TO-247AB
YJD212030NCFGHQ	1200V	30 mΩ	GH	78	305	198	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD212030T2GHQ	1200V	30 mΩ	GH	82	305	198	395	0.38	175	T2PAK
YJD212040NCFG2Q	1200V	33 mΩ	Gen2	66	116	127	333	0.45	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG2Q	1200V	33 mΩ	Gen2	66	116	127	333	0.45	175	TO247-AB
YJD212040NCTGHQ	1200V	40 mΩ	GH	62	229	149	326	0.46	175	TO-247AB
YJD212040NCFGHQ	1200V	40 mΩ	GH	62	229	149	326	0.46	175	TO-247-4L
YJD212040T2GHQ	1200V	40 mΩ	GH	68	229	149	357	0.42	175	T2PAK
YJD212040NCFG1Q	1200V	40 mΩ	Gen1	63	120	141	300	0.42	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG1Q	1200V	40 mΩ	Gen1	63	120	141	300	0.42	175	TO-247AB
YJD212060NCTGHQ	1200V	60 mΩ	GH	44.5	129	115	250	0.6	175	TO-247AB
YJD212060NCFGHQ	1200V	60 mΩ	GH	44.5	129	115	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD212060B7GHQ	1200V	60 mΩ	GH	42	129	115	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD212060T2GHQ	1200V	60 mΩ	GH	47	129	115	258	0.58	175	T2PAK
YJD212080NCTG1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	38	41	58	220	0.68	175	TO-247AB
YJD212080NCFG1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	39	41	58	223	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7G1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	30	41	58	135	1.1	175	TO263-7L
YJD212080NCTGHQ	1200V	80 mΩ	GH	33	131	85	224	0.67	175	TO-247AB
YJD212080NCFGHQ	1200V	80 mΩ	GH	33	131	85	224	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7GHQ	1200V	80 mΩ	GH	30	131	85	136	1.1	175	TO-263-7L
YJD212080T2GHQ	1200V	80 mΩ	GH	34	131	85	234	0.64	175	T2PAK
YJD2120120NCTGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24	67	56	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2120120NCFGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24	67	56	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2120120BGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24.5	67	56	166	0.85	175	D2PAK
YJD2120120B7GHQ	1200V	120 mΩ	GH	24.5	67	56	166	0.85	175	TO-263-7L
YJD2120160NCFG1Q	1200V	160 mΩ	Gen1	21	39	47	157	0.95	175	TO-247-4L
YJD2120160NCTG1Q	1200V	160 mΩ	Gen1	21	39	47	157	0.95	175	TO-247AB
YJD206520NCTGHQ	650V	20 mΩ	GH	107	287	359	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206520NCFGHQ	650V	20 mΩ	GH	107	287	359	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525NCTGHQ	650V	25 mΩ	GH	107	275	358	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206525NCFGHQ	650V	25 mΩ	GH	107	275	358	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525T2GHQ	650V	25 mΩ	GH	112	275	358	395	0.38	175	T2PAK
YJD206530NCFG1Q	650V	30 mΩ	Gen1	65	101	185	260	0.48	175	TO-247AB
YJD206530NCTG1Q	650V	30 mΩ	Gen1	65	101	185	260	0.48	175	TO-247-4L
YJD206550NCTGHQ	650V	50 mΩ	GH	60	121	208	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206550NCFGHQ	650V	50 mΩ	GH	60	121	208	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206550B7GHQ	650V	50 mΩ	GH	57	121	208	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTGHQ	650V	60 mΩ	GH	60	116	205	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206560NCFGHQ	650V	60 mΩ	GH	60	116	205	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206560B7GHQ	650V	60 mΩ	GH	57	116	205	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTG1Q	650V	60 mΩ	Gen1	37	46	71	153	0.98	175	TO-247AB
YJD206560NCFG1Q	650V	60 mΩ	Gen1	37	46	71	153	0.98	175	TO-247-4L
YJD2065100NCTGHQ	650V	100 mΩ	GH	32	66	105	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2065100NCFGHQ	650V	100 mΩ	GH	32	66	105	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2065100B7GHQ	650V	100 mΩ	GH	35	66	105	200	0.75	175	TO-263-7L

SiC MOSFET
SiC MOSFET

SiC MOSFET										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25℃	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{tot} (W)	R _{thJC} (°C/W)	T _J (℃)	Package
YJD212030NCTGH	1200V	30 mΩ	GH	78	305	198	375	0.4	175	TO-247AB
YJD212030NCFGH	1200V	30 mΩ	GH	78	305	198	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD212030T2GH	1200V	30 mΩ	GH	82	305	198	395	0.38	175	T2PAK
YJD212040NCFG2	1200V	33 mΩ	Gen2	66	116	127	333	0.45	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG2	1200V	33 mΩ	Gen2	66	116	127	333	0.45	175	TO247-AB
YJD212040NCTGH	1200V	40 mΩ	GH	62	229	149	326	0.46	175	TO-247AB
YJD212040NCFGH	1200V	40 mΩ	GH	62	229	149	326	0.46	175	TO-247-4L
YJD212040T2GH	1200V	40 mΩ	GH	68	229	149	357	0.42	175	T2PAK
YJD212040NCFG1	1200V	40 mΩ	Gen1	63	120	141	300	0.42	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG1	1200V	40 mΩ	Gen1	63	120	141	300	0.42	175	TO-247AB
YJD212060NCTGH	1200V	60 mΩ	GH	44.5	129	115	250	0.6	175	TO-247AB
YJD212060NCFGH	1200V	60 mΩ	GH	44.5	129	115	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD212060B7GH	1200V	60 mΩ	GH	42	129	115	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD212060T2GH	1200V	60 mΩ	GH	47	129	115	258	0.58	175	T2PAK
YJD212080NCTG1	1200V	77 mΩ	Gen1	38	41	58	220	0.68	175	TO-247AB
YJD212080NCFG1	1200V	77 mΩ	Gen1	39	41	58	223	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7G1	1200V	77 mΩ	Gen1	30	41	58	135	1.1	175	TO263-7L
YJD212080NCTGH	1200V	80 mΩ	GH	33	131	85	224	0.67	175	TO-247AB
YJD212080NCFGH	1200V	80 mΩ	GH	33	131	85	224	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7GH	1200V	80 mΩ	GH	30	131	85	136	1.1	175	TO-263-7L
YJD212080T2GH	1200V	80 mΩ	GH	34	131	85	234	0.64	175	T2PAK
YJD2120120NCTGH	1200V	120 mΩ	GH	24	67	56	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2120120NCFGH	1200V	120 mΩ	GH	24	67	56	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2120120BGH	1200V	120 mΩ	GH	24.5	67	56	166	0.85	175	D2PAK
YJD2120120B7GH	1200V	120 mΩ	GH	24.5	67	56	166	0.85	175	TO-263-7L
YJD2120160NCFG1	1200V	160 mΩ	Gen1	21	39	47	157	0.95	175	TO-247-4L
YJD2120160NCTG1	1200V	160 mΩ	Gen1	21	39	47	157	0.95	175	TO-247AB
YJD2120240NCTGH	1200V	240 mΩ	GH	13.5	47	36	105	1.42	175	TO-247AB
YJD2120240NCFGH	1200V	240 mΩ	GH	13.5	47	36	105	1.42	175	TO-247-4L
YJD2120240BGH	1200V	240 mΩ	GH	13.5	47	36	105	0.93	175	D2PAK
YJD2120240B7GH	1200V	240 mΩ	GH	13.5	47	36	105	0.93	175	TO-263-7L
YJD206520NCTGH	650V	20 mΩ	GH	107	287	359	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206520NCFGH	650V	20 mΩ	GH	107	287	359	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525NCTGH	650V	25 mΩ	GH	107	275	358	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206525NCFGH	650V	25 mΩ	GH	107	275	358	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525T2GH	650V	25 mΩ	GH	112	275	358	395	0.38	175	T2PAK
YJD206530NCFG1	650V	30 mΩ	Gen1	65	101	185	260	0.48	175	TO-247AB
YJD206530NCTG1	650V	30 mΩ	Gen1	65	101	185	260	0.48	175	TO-247-4L
YJD206550NCTGH	650V	50 mΩ	GH	60	121	208	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206550NCFGH	650V	50 mΩ	GH	60	121	208	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206550B7GH	650V	50 mΩ	GH	57	121	208	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTGH	650V	60 mΩ	GH	60	116	205	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206560NCFGH	650V	60 mΩ	GH	60	116	205	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206560B7GH	650V	60 mΩ	GH	57	116	205	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTG1	650V	60 mΩ	Gen1	37	46	71	153	0.98	175	TO-247AB

SiC MOSFET										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25℃	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	T _J (℃)	Package
YJD206560NCFG1	650V	60 mΩ	Gen1	37	46	71	153	0.98	175	TO-247-4L
YJD2065100NCTGH	650V	100 mΩ	GH	32	66	105	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2065100NCFGH	650V	100 mΩ	GH	32	66	105	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2065100B7GH	650V	100 mΩ	GH	35	66	105	200	0.75	175	TO-263-7L
YJD2065200NCTGH	650V	200 mΩ	GH	16	43	67	89	1.4	175	TO-247AB
YJD2065200NCFGH	650V	200 mΩ	GH	16	43	67	89	1.4	175	TO-247-4L
YJD2065200BGH	650V	200 mΩ	GH	19	43	67	120	1.25	175	D2PAK
YJD2065200B7GH	650V	200 mΩ	GH	19	43	67	120	1.25	175	TO-263-7L
YJD217045NCTGH	1700V	45 mΩ	GH	55	304	145	375	0.4	175	TO-247AB
YJD217045NCFGH	1700V	45 mΩ	GH	55	304	145	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD21701K0NCTGH	1700V	1000 mΩ	GH	4.2	31	14	51	2.9	175	TO-247AB
YJD21701K0NCFGH	1700V	1000 mΩ	GH	4.2	31	14	51	2.9	175	TO-247-4L
YJD21701K0BGH	1700V	1000 mΩ	GH	4.7	31	14	51	2	175	D2PAK
YJD21701K0B7GH	1700V	1000 mΩ	GH	4.7	31	14	51	2	175	TO-263-7L

Sic肖特基二极管
SiC SBD

SiC SBD										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	VF (V)	IR (uA)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	Package
YJD106502DQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	43	3.62	TO-252/DPAK
YJD106502PQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	45	3.3	TO-220AC
YJD106504DG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	59	2.52	TO-252/DPAK
YJD106504PG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	56	2.65	TO-220AC
YJD106506DQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	100	1.49	TO-252/DPAK
YJD106506BQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.75	TO-263/D2PAK
YJD106506PQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.78	TO-220AC
YJD106506FQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	31	4.76	ITO-220AC
YJD106508DQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106508BQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106508PQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106508FQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106510DQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106510BQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106510PQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106510FQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106520NCTQG2	650V	20A	Gen2	1.35*	0.5	70*	30	230**	0.65**	TO-247AB
YJD106520DQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	150	1	TO-252/DPAK
YJD106520BQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	144	1.04	TO-263/D2PAK
YJD106520PQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	170	0.88	TO-220AC
YJD106520FQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	47	3.20	ITO-220AC
YJD106520NQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	187	0.80	TO-247AC
YJD106540NCTQG2	650V	40A	Gen2	1.35*	1	160*	62	365**	0.41**	TO-247AB
YJD106550NQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	454	0.33	TO-247AC
YJD106550BQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	375	0.4	TO-263/D2PAK
YJD112002DG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	46	3.30	TO-252/DPAK
YJD112002PG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	47	3.20	TO-220AC
YJD112005DG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	57	2.60	TO-252/DPAK
YJD112005PG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	79	1.90	TO-220AC

SiC SBD										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	VF (V)	IR (uA)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	Package
YJD112005FG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	31	4.80	ITO-220AC
YJD112010NQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	266	0.56	TO-247AC
YJD112010FQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	36	4.1	ITO-220AC
YJD112010PQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	170	0.88	TO-220AC
YJD112010DQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	189	0.79	TO-252/DPAK
YJD112010BQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112010BXQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112015NG1	1200V	15A	Gen1	1.46	1	180	89.8	326	0.46	TO-247AC
YJD112015NGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	144	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112015PGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	140	114	241	0.62	TO-220AC
YJD112030NCTG1	1200V	30A	Gen1	1.46*	2	180*	89.8*	625	0.24	TO-247AB
YJD112030NCTGG2	1200V	30A	Gen2	1.24*	1	140*	110*	588**	0.25**	TO-247AB
YJD112020BGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020BXGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020NCTQG2	1200V	20A	Gen2	1.42*	1.3	85*	53*	500**	0.3**	TO-247AB
YJD112020NGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112040NCTG1	1200V	40A	Gen1	1.43*	8	160*	112.4*	600	0.25	TO-247AB
YJD112040NCTGG2	1200V	40A	Gen2	1.34*	1	160*	114*	625**	0.24**	TO-247AB
YJD112030NG1	1200V	30A	Gen1	1.54	1	240	153	394	0.38	TO-247AC
YJD112030NQG2	1200V	30A	Gen2	1.43	3.4	225	162	416	0.36	TO-247AC
YJD112030NGG2	1200V	30A	Gen2	1.28	1	265	222	573	0.26	TO-247AC
YJD112030NGG3	1200V	30A	Gen3	1.54	0.5	250	122	326	0.46	TO-247AC
YJD112040NQG2	1200V	40A	Gen2	1.41	3.1	280	216	440	0.34	TO-247AC
YJD112040NGG2	1200V	40A	Gen2	1.38	1	300	222	573	0.26	TO-247AC

*per leg, ** Per Device

Sic SBD 模块
SiC SBD MODULE

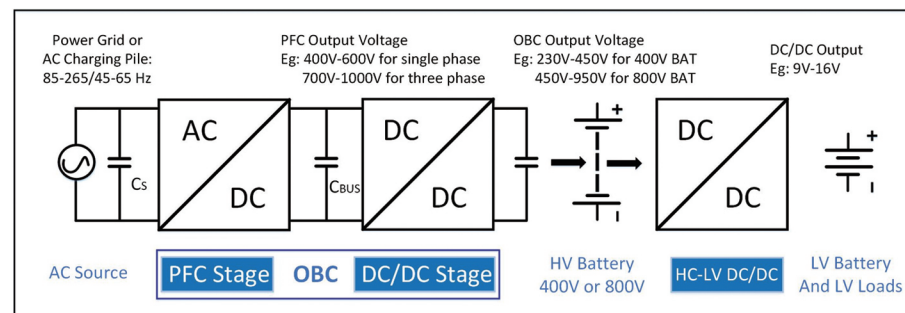
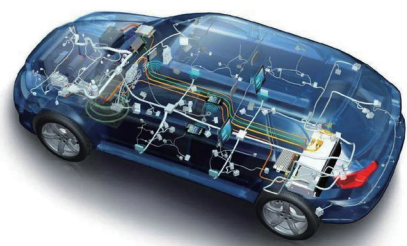
SiC SBD MODULE										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	VF (V)	IR (uA)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	Package
MB60DU12FJ	1200V	60A	Gen1	1.41	3.6	225	171	250	0.6	SOT-227(灌胶)
MB80DU12FJ	1200V	80A	Gen1	1.36	7.1	306	224	360	0.39	SOT-227(灌胶)
MB120DU12FJ	1200V	120A	Gen1	1.46	10	420	325	410	0.367	SOT-227(灌胶)
MB180DU065FJ	650V	180A	Gen1	1.45	12	600	186	441	0.34	SOT-227(灌胶)
MB180DU12FJ	1200V	180A	Gen1	1.49	30.1	625	488	520	0.288	SOT-227(灌胶)
MB200DU12FJ	1200V	200A	Gen1	1.53	30.1	625	488	520	0.288	SOT-227(灌胶)
MB60DU12ST	1200V	60A	Gen1	1.41	3.6	225	171	250	0.62	SOT-227(塑封)
MB80DU12ST	1200V	80A	Gen1	1.36	7.1	306	224	360	0.41	SOT-227(塑封)
MB120DU12ST	1200V	120A	Gen1	1.49	2.4	450	326	410	0.37	SOT-227(塑封)
MB200DU12ST	1200V	200A	Gen1	1.53	30.1	625	488	476	0.315	SOT-227(塑封)
MB480U12F2	1200V	480A	Gen1	1.5	58	3300	2670	682	0.22	34mm(灌胶)
MB480U065F2	1200V	480A	Gen1	1.5	86	3192	1923	682	0.22	34mm(灌胶)

Sic MOSFET 模块
SiC MOSFET MODULE

SiC MOSFET MODULE											
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	ID (A)	Generation	R _{DS(ON)} (mΩ) @25℃	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	T _J (℃)	Package	
MC16UZ12STN	1200V	128A	Gen1	16	269	207	461	0.325	175	SOT-227(塑封)	

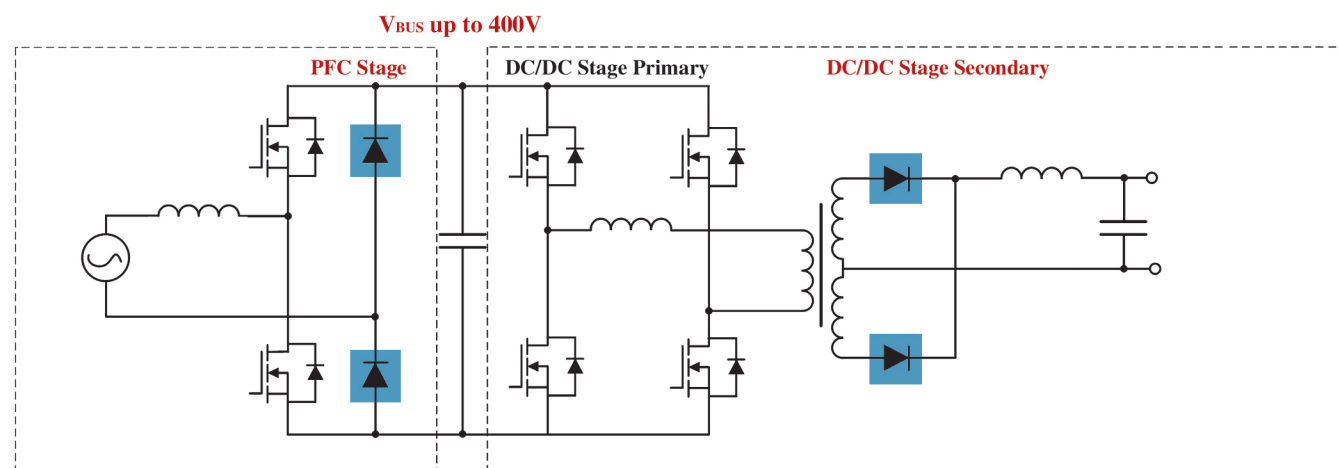
AUTOMOTIVE SiC DEVICE (650V ~ 1200V)

SiC 可有效提高新能源汽车能效转换，提高续航里程或减小电池尺寸，从而节省新能源汽车空间和成本。针对 EV/HEV 的电动汽车车载充电系统（OBC）PFC 和 DC/DC 次级整流、电源转换系统（车载 DC/DC）终端，扬杰科技提供多种型号车规级 SiC SBD 和 SiC MOSFET 分立器件。

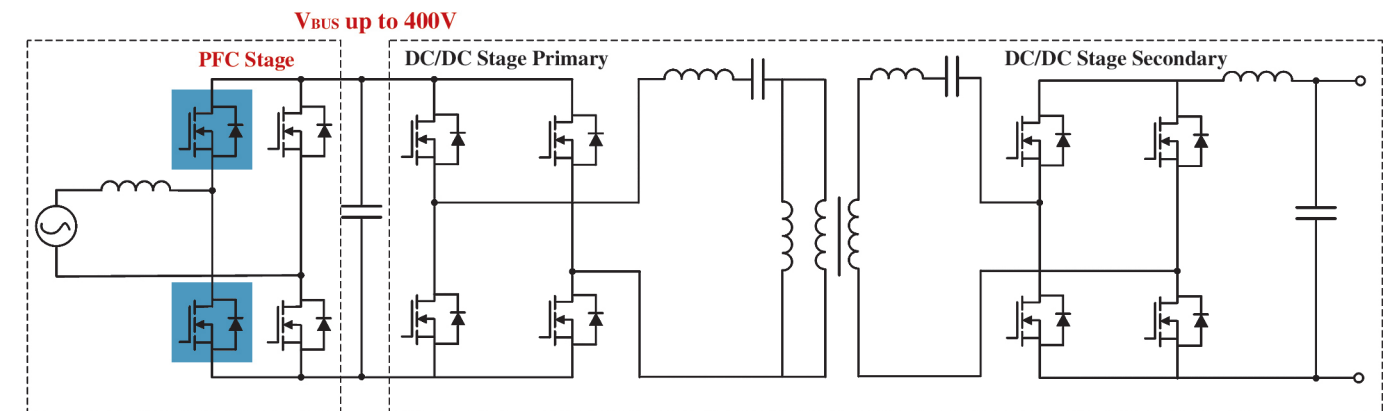


车载充电系统（OBC）和电源转换系统（车载 DC/DC）

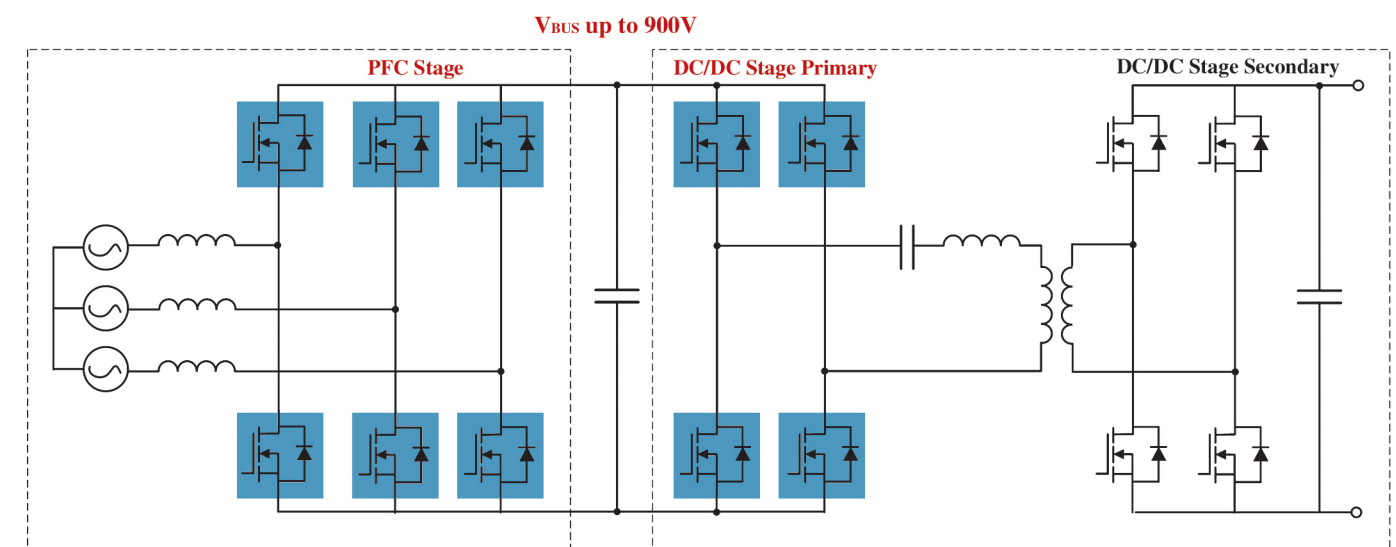
车载 OBC 分为 PFC 和 DC/DC 两级。其中，对于单相交流输入的 PFC，其输出直流母线电压通常为 400~600V，而对于三相输入的 PFC，其输出直流母线电压通常为 700~1000V。由于单级 PFC 输出的直流电流有比较大的低频波动，所以典型的 OBC 系统在 PFC 级后还会有 DC/DC 变换器级，其输出给车载高压动力电池供电。



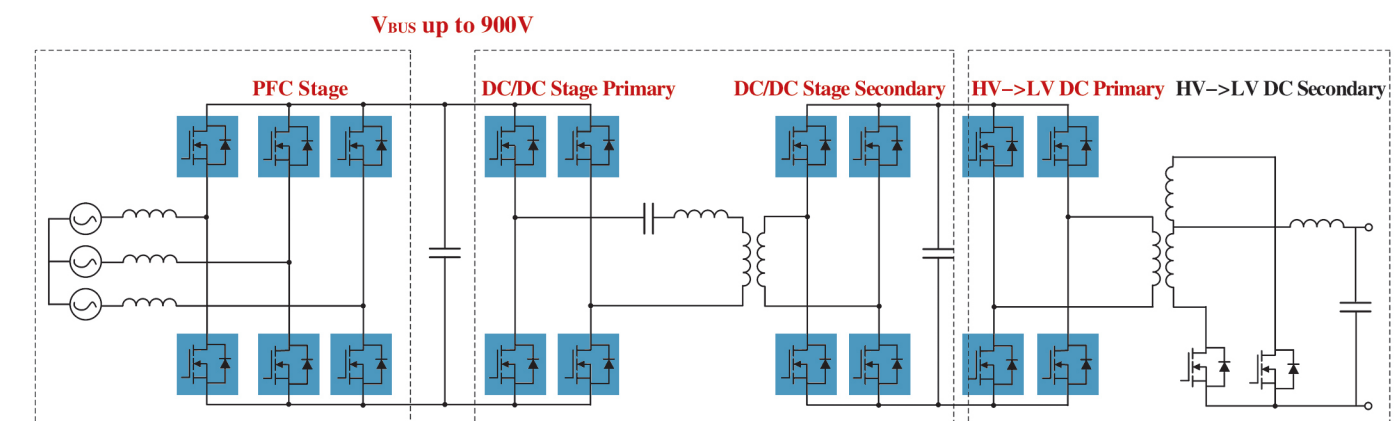
单相 OBC 及移相全桥 DC/DC SiC SBD 应用位置



400V 单相双向 OBC 中 SiC MOSFET 应用位置



400V 三相 11kW 双向 OBC 中 SiC MOSFET 应用位置



800V 三相 OBC 及移相全桥 DC/DC SiC MOSFET 应用位置

SiC MOSFET OBC										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25 °C	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{tot} (W)	R _{thJC} (°C/W)	T _J (°C)	Package
YJD212030NCTGHQ	1200V	30 mΩ	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247AB
YJD212030NCFGHQ	1200V	30 mΩ	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD212030T2GHQ	1200V	30 mΩ	GH	82	305	198	395	0.38	175	T2PAK
YJD212040NCFG2Q	1200V	33 mΩ	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG2Q	1200V	33 mΩ	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO247-AB
YJD212040NCTGHQ	1200V	40 mΩ	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247AB
YJD212040NCFGHQ	1200V	40 mΩ	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247-4L
YJD212040T2GHQ	1200V	40 mΩ	GH	68	229	149	357	0.42	175	T2PAK
YJD212040NCFG1Q	1200V	40 mΩ	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG1Q	1200V	40 mΩ	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247AB
YJD212060NCTGHQ	1200V	60 mΩ	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247AB
YJD212060NCFGHQ	1200V	60 mΩ	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD212060B7GHQ	1200V	60 mΩ	GH	42A	129	115	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD212060T2GHQ	1200V	60 mΩ	GH	47	129	115	258	0.58	175	T2PAK
YJD212080NCTG1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	38A	41	58	220	0.68	175	TO-247AB
YJD212080NCFG1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	39A	41	58	223	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7G1Q	1200V	77 mΩ	Gen1	30A	41	58	135	1.1	175	TO263-7L
YJD212080NCTGHQ	1200V	80 mΩ	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247AB
YJD212080NCFGHQ	1200V	80 mΩ	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7GHQ	1200V	80 mΩ	GH	30A	131	85	136	1.1	175	TO-263-7L
YJD212080T2GHQ	1200V	80 mΩ	GH	34	131	85	234	0.64	175	T2PAK
YJD2120120NCTGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2120120NCFGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2120120BGHQ	1200V	120 mΩ	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	D2PAK
YJD2120120B7GHQ	1200V	120 mΩ	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	TO-263-7L
YJD2120160NCFG1Q	1200V	160 mΩ	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247-4L
YJD2120160NCTG1Q	1200V	160 mΩ	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247AB
YJD206520NCTGHQ	650V	20 mΩ	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206520NCFGHQ	650V	20 mΩ	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525NCTGHQ	650V	25 mΩ	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206525NCFGHQ	650V	25 mΩ	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525T2GHQ	650V	25 mΩ	GH	112	275	358	395	0.38	175	T2PAK
YJD206530NCFG1Q	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247AB
YJD206530NCTG1Q	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247-4L
YJD206550NCTGHQ	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206550NCFGHQ	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206550B7GHQ	650V	50 mΩ	GH	57A	121	208	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTGHQ	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206560NCFGHQ	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206560B7GHQ	650V	60 mΩ	GH	57A	116	205	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTG1Q	650V	60 mΩ	Gen1	37A	46	71	153	0.98	175	TO-247AB
YJD206560NCFG1Q	650V	60 mΩ	Gen1	37A	46	71	153	0.98	175	TO-247-4L

SiC SBD OBC										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	VF (V)	IR (μA)	IFSM (A)	QC (nC)	PTOT (W)	R _{thJC} (°C/W)	Package
YJD106510DQG2Q	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106510BQG2Q	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106510PQG2Q	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106510FQG2Q	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106520NCTQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35*	0.5	70*	30	230**	0.65**	TO-247AB
YJD106520DQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	150	1	TO-252/DPAK
YJD106520BQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	144	1.04	TO-263/D2PAK
YJD106520PQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	170	0.88	TO-220AC
YJD106520FQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	47	3.20	ITO-220AC
YJD106520NQG2Q	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	187	0.80	TO-247AC

*per leg, ** Per Device



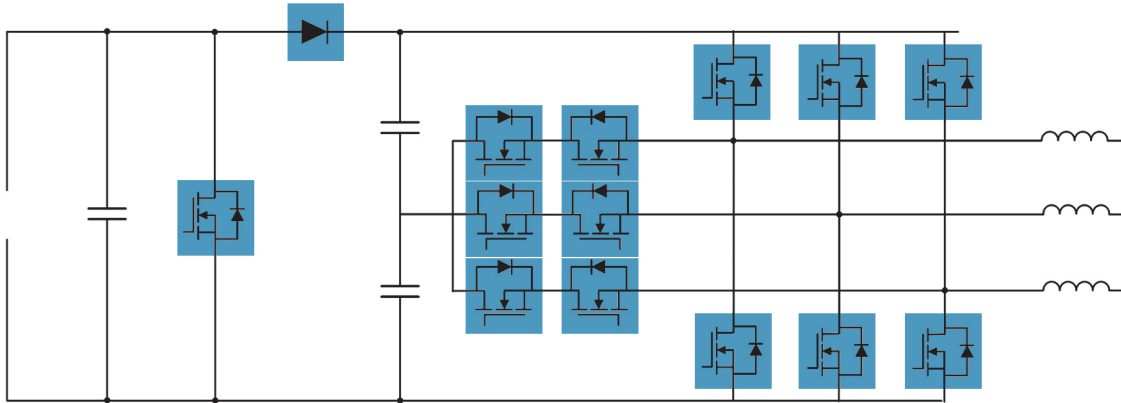
清洁能源应用 + 产品推介

Clean Energy & Product Introduction

INDUSTRIAL SiC DEVICE (650V ~ 1700V)

针对光储充等可再生能源系统应用，以及电源和工业电机驱动等应用，扬杰科技提供工控级 SiC SBD 和 SiC MOSFET 分立器件。

光伏储能逆变



NPC T 型三电平拓扑结构

SIC SBD										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	V _F (V)	IR (μ A)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJC} ($^{\circ}$ C/W)	Package
YJD106502DQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	43	3.62	TO-252/DPAK
YJD106502PQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	45	3.3	TO-220AC
YJD106504DG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	59	2.52	TO-252/DPAK
YJD106504PG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	56	2.65	TO-220AC
YJD106506DQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	100	1.49	TO-252/DPAK
YJD106506BQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.75	TO-263/D2PAK
YJD106506PQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.78	TO-220AC
YJD106506FQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	31	4.76	ITO-220AC
YJD106508DQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106508BQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106508PQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106508FQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106510DQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106510BQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106510PQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106510FQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106520NCTQG2	650V	20A	Gen2	1.35*	0.5	70*	30	230**	0.65**	TO-247AB
YJD106520DQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	150	1	TO-252/DPAK
YJD106520BQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	144	1.04	TO-263/D2PAK
YJD106520PQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	170	0.88	TO-220AC
YJD106520FQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	47	3.20	ITO-220AC
YJD106520NQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	187	0.80	TO-247AC
YJD106540NCTQG2	650V	40A	Gen2	1.35*	1	160*	62	365**	0.41**	TO-247AB
YJD106550NQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	454	0.33	TO-247AC
YJD106550BQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	375	0.4	TO-263/D2PAK
YJD112002DG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	46	3.30	TO-252/DPAK
YJD112002PG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	47	3.20	TO-220AC
YJD112005DG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	57	2.60	TO-252/DPAK
YJD112005PG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	79	1.90	TO-220AC
YJD112005FG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	31	4.80	ITO-220AC
YJD112015NG1	1200V	15A	Gen1	1.46	1	180	89.8	326	0.46	TO-247AC
YJD112030NCTG1	1200V	30A	Gen1	1.46*	2	180*	89.8*	625	0.24	TO-247AB
YJD112040NCTG1	1200V	40A	Gen1	1.43*	8	160*	112.4*	600	0.25	TO-247AB
YJD112030NG1	1200V	30A	Gen1	1.54	1	240	153	394	0.38	TO-247AC
YJD112010NQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	266	0.56	TO-247AC
YJD112010FQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	36	4.1	ITO-220AC
YJD112010PQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	170	0.88	TO-220AC
YJD112010DQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	189	0.79	TO-252/DPAK
YJD112010BQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112010BXQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112015NGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	144	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112015PGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	140	114	241	0.62	TO-220AC
YJD112030NCTGG2	1200V	30A	Gen2	1.24*	1	140*	110*	588**	0.25**	TO-247AB
YJD112020BGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020BXGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020NCTQG2	1200V	20A	Gen2	1.42*	1.3	85*	53*	500**	0.3**	TO-247AB
YJD112020NGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112040NCTGG2	1200V	40A	Gen2	1.34*	1	160*	114*	625**	0.24**	TO-247AB
YJD112030NQG2	1200V	30A	Gen2	1.43	3.4	225	162	416	0.36	TO-247AC
YJD112030NGG2	1200V	30A	Gen2	1.28	1	265	222	573	0.26	TO-247AC
YJD112030NGG3	1200V	30A	Gen3	1.54	0.5	250	122	326	0.46	TO-247AC
YJD112040NGG2	1200V	40A	Gen2	1.38	1	300	222	573	0.26	TO-247AC

SIC SBD MODULE										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	V _F (V)	IR (μ A)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJC} ($^{\circ}$ C/W)	Package
MB60DU12FJ	1200V	60A	Gen1	1.41	3.6	225	171	250	0.6	SOT-227(灌胶)
MB80DU12FJ	1200V	80A	Gen1	1.36	7.1	306	224	360	0.39	SOT-227(灌胶)
MB120DU12FJ	1200V	120A	Gen1	1.46	10	420	325	410	0.367	SOT-227(灌胶)
MB180DU065FJ	650V	180A	Gen1	1.45	12	600	186	441	0.34	SOT-227(灌胶)
MB180DU12FJ	1200V	180A	Gen1	1.49	30.1	625	488	520	0.288	SOT-227(灌胶)
MB200DU12FJ	1200V	200A	Gen1	1.53	30.1	625	488	520	0.288	SOT-227(灌胶)
MB60DU12ST	1200V	60A	Gen1	1.41	3.6	225	171	250	0.62	SOT-227(塑封)
MB80DU12ST	1200V	80A	Gen1	1.36	7.1	306	224	360	0.41	SOT-227(塑封)
MB120DU12ST	1200V	120A	Gen1	1.49	2.4	450	326	410	0.37	SOT-227(塑封)
MB200DU12ST	1200V	200A	Gen1	1.53	30.1	625	488	476	0.315	SOT-227(塑封)
MB480U12F2	1200V	480A	Gen1	1.5	58	3300	2670	682	0.22	34mm(灌胶)
MB480U065F2	1200V	480A	Gen1	1.5	86	3192	1923	682	0.22	34mm(灌胶)

*per leg, ** Per Device

SIC MOSFET										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (m Ω) @25 $^{\circ}$ C	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{thJC} ($^{\circ}$ C/W)	T _J ($^{\circ}$ C)	Package
YJD212030NCTGH	1200V	30 m Ω	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247AB
YJD212030NCFGH	1200V	30 m Ω	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD212030T2GH	1200V	30 m Ω	GH	82	305	198	395	0.38	175	T2PAK
YJD212040NCFG2	1200V	33 m Ω	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG2	1200V	33 m Ω	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO247-AB
YJD212040NCTGH	1200V	40 m Ω	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247AB
YJD212040NCFGH	1200V	40 m Ω	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247-4L
YJD212040T2GH	1200V	40 m Ω	GH	68	229	149	357	0.42	175	T2PAK
YJD212040NCFG1	1200V	40 m Ω	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG1	1200V	40 m Ω	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247AB
YJD212060NCTGH	1200V	60 m Ω	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247AB
YJD212060NCFGH	1200V	60 m Ω	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD212060B7GH	1200V	60 m Ω	GH	42A	129	115	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD212060T2GH	1200V	60 m Ω	GH	47	129	115	258	0.58	175	T2PAK
YJD212080NCTG1	1200V	77 m Ω	Gen1	38A	41	58	220	0.68	175	TO-247AB
YJD212080NCFG1	1200V	77 m Ω	Gen1	39A	41	58	223	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7G1	1200V	77 m Ω	Gen1	30A	41	58	135	1.1	175	TO263-7L
YJD212080NCTGH	1200V	80 m Ω	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247AB
YJD212080NCFGH	1200V	80 m Ω	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7GH	1200V	80 m Ω	GH	30A	131	85	136	1.1	175	TO-263-7L
YJD212080T2GH	1200V	80 m Ω	GH	34	131	85	234	0.64	175	T2PAK
YJD2120120NCTGH	1200V	120 m Ω	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2120120NCFGH	1200V	120 m Ω	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2120120BGH	1200V	120 m Ω	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	D2PAK
YJD2120120B7GH	1200V	120 m Ω	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	TO-263-7L
YJD2120160NCFG1	1200V	160 m Ω	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247-4L
YJD2120160NCTG1	1200V	160 m Ω	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247AB
YJD206520NCTGH	650V	20 m Ω	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206520NCFGH	650V	20 m Ω	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525NCTGH	650V	25 m Ω	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247AB

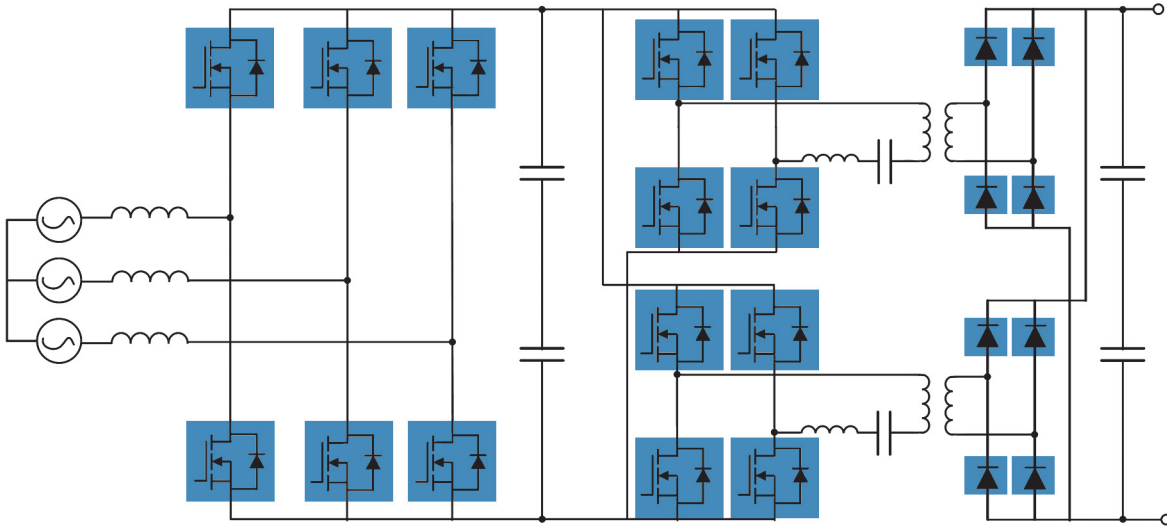
SiC MOSFET										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25 °C	Generation	ID (A)	Qg (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	Tj (°C)	Package
YJD206525NCFGH	650V	25 mΩ	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525T2GH	650V	25 mΩ	GH	112	275	358	395	0.38	175	T2PAK
YJD206530NCFG1	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247AB
YJD206530NCTG1	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247-4L
YJD206550NCTGH	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206550NCFGH	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206550B7GH	650V	50 mΩ	GH	57A	121	208	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTGH	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206560NCFGH	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206560B7GH	650V	60 mΩ	GH	57A	116	205	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTG1	650V	60 mΩ	Gen1	37A	46	71	153	0.98	175	TO-247AB
YJD206560NCFG1	650V	60 mΩ	Gen1	37A	46	71	153	0.98	175	TO-247-4L
YJD2065100NCTGH	650V	100 mΩ	GH	32A	66	105	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2065100NCFGH	650V	100 mΩ	GH	32A	66	105	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2065100B7GH	650V	100 mΩ	GH	35A	66	105	200	0.75	175	TO-263-7L
YJD217045NCTGH	1700V	45 mΩ	GH	55	304	145	375	0.4	175	TO-247AB
YJD217045NCFGH	1700V	45 mΩ	GH	55	304	145	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD21701K0NCTGH	1700V	1000 mΩ	GH	4.2	31	14	51	2.9	175	TO-247AB
YJD21701K0NCFGH	1700V	1000 mΩ	GH	4.2	31	14	51	2.9	175	TO-247-4L
YJD21701K0B7GH	1700V	1000 mΩ	GH	4.7	31	14	51	2	175	D2PAK
YJD21701K0B7GH	1700V	1000 mΩ	GH	4.7	31	14	51	2	175	TO-263-7L

SiC MOSFET MODULE										
Product Name	V _{BRDSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25 °C	Generation	ID (A)	Qg (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{thJA} (°C/W)	Tj (°C)	Package
MC16UZ12STN	1200V	16 mΩ	Gen1	128A	269	207	461	0.325	175	SOT-227(塑封)

充电桩应用 + 产品推介

Charging Pile & Product Introduction

充电桩



三相全桥 PFC 整流充电桩模块电路

SiC SBD										
Product Name	V _{BR_min} (V)	IF (A)	Generation	VF (V)	IR (μA)	IFSM (A)	QC (nC)	P _{TOT} (W)	R _{thJC} (°C/W)	Package
YJD106502DQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	43	3.62	TO-252/DPAK
YJD106502PQG3	650V	2A	Gen3	1.5	0.1	20	5.2	45	3.3	TO-220AC
YJD106504DG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	59	2.52	TO-252/DPAK
YJD106504PG1	650V	4A	Gen1	1.4	3	26	12	56	2.65	TO-220AC
YJD106506DQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	100	1.49	TO-252/DPAK
YJD106506BQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.75	TO-263/D2PAK
YJD106506PQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	84	1.78	TO-220AC
YJD106506FQG2	650V	6A	Gen2	1.31	0.5	65	25	31	4.76	ITO-220AC
YJD106508DQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106508BQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106508PQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106508FQG2	650V	8A	Gen2	1.3	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106510DQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	132	1.14	TO-252/DPAK
YJD106510BQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-263/D2PAK
YJD106510PQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	136	1.1	TO-220AC
YJD106510FQG2	650V	10A	Gen2	1.35	0.5	70	30	43	3.5	ITO-220AC
YJD106520NCTQG2	650V	20A	Gen2	1.35*	0.5	70*	30	230**	0.65**	TO-247AB
YJD106520DQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	150	1	TO-252/DPAK
YJD106520BQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	144	1.04	TO-263/D2PAK
YJD106520PQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	170	0.88	TO-220AC
YJD106520FQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	47	3.20	ITO-220AC
YJD106520NQG2	650V	20A	Gen2	1.35	1	160	62	187	0.80	TO-247AC
YJD106540NCTQG2	650V	40A	Gen2	1.35*	1	160*	62	365**	0.41**	TO-247AB
YJD106550NQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	454	0.33	TO-247AC
YJD106550BQG3	650V	50A	Gen3	1.45	3	380	135.3	375	0.4	TO-263/D2PAK
YJD112002DG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	46	3.30	TO-252/DPAK
YJD112002PG1	1200V	2A	Gen1	1.41	3	25	14	47	3.20	TO-220AC
YJD112005DG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	57	2.60	TO-252/DPAK
YJD112005PG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	79	1.90	TO-220AC
YJD112005FG1	1200V	5A	Gen1	1.4	1.8	52	37	31	4.80	ITO-220AC
YJD112015NG1	1200V	15A	Gen1	1.46	1	180	89.8	326	0.46	TO-247AC
YJD112030NCTG1	1200V	30A	Gen1	1.46*	2	180*	89.8*	625	0.24	TO-247AB
YJD112040NCTG1	1200V	40A	Gen1	1.43*	8	160*	112.4*	600	0.25	TO-247AB
YJD112030NG1	1200V	30A	Gen1	1.54	1	240	153	394	0.38	TO-247AC
YJD112010NQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	266	0.56	TO-247AC
YJD112010FQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	36	4.1	ITO-220AC
YJD112010PQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	170	0.88	TO-220AC
YJD112010DQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	189	0.79	TO-252/DPAK
YJD112010BQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112010BXQG2	1200V	10A	Gen2	1.42	1.3	85	53	158	0.95	TO-263/D2PAK
YJD112015NGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	144	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112015PGG2	1200V	15A	Gen2	1.25	0.5	140	114	241	0.62	TO-220AC
YJD112030NCTGG2	1200V	30A	Gen2	1.24*	1	140*	110*	588**	0.25**	TO-247AB
YJD112020BGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020BXGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	238	0.63	TO-263/D2PAK
YJD112020NGG2	1200V	20A	Gen2	1.34	0.5	160	114	319	0.47	TO-247AC
YJD112040NCTGG2	1200V	40A	Gen2	1.34*	1	160*	114*	625**	0.24**	TO-247AB
YJD112030NQG2	1200V	30A	Gen2	1.43	3.4	225	162	416	0.36	TO-247AC
YJD112030NGG2	1200V	30A	Gen2	1.28	1	265	222	573	0.26	TO-247AC
YJD112030NGG3	1200V	30A	Gen3	1.54	0.5	250	122	326	0.46	TO-247AC
YJD112040NQG2	1200V	40A	Gen2	1.41	3.1	280	216	440	0.34	TO-247AC
YJD112040NGG2	1200V	40A	Gen2	1.38	1	300	222	573	0.26	TO-247AC

*per leg, ** Per Device

SiC MOSFET										
Product Name	V _{BRSS_min} (V)	R _{DS(ON)} (mΩ) @25 °C	Generation	ID (A)	Q _g (nC)	C _{oss} (pF)	P _{TOT} (W)	R _{th-JC} (°C/W)	T _J (°C)	Package
YJD212030NCTGH	1200V	30 mΩ	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247AB
YJD212030NCFGH	1200V	30 mΩ	GH	78A	305	198	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD212030T2GH	1200V	30 mΩ	GH	82	305	198	395	0.38	175	T2PAK
YJD212040NCFG2	1200V	33 mΩ	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG2	1200V	33 mΩ	Gen2	66A	116	127	333	0.45	175	TO247-AB
YJD212040NCTGH	1200V	40 mΩ	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247AB
YJD212040NCFGH	1200V	40 mΩ	GH	62A	229	149	326	0.46	175	TO-247-4L
YJD212040T2GH	1200V	40 mΩ	GH	68	229	149	357	0.42	175	T2PAK
YJD212040NCFG1	1200V	40 mΩ	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247-4L
YJD212040NCTG1	1200V	40 mΩ	Gen1	63A	120	141	300	0.42	175	TO-247AB
YJD212060NCTGH	1200V	60 mΩ	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247AB
YJD212060NCFGH	1200V	60 mΩ	GH	44.5A	129	115	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD212060B7GH	1200V	60 mΩ	GH	42A	129	115	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD212060T2GH	1200V	60 mΩ	GH	47	129	115	258	0.58	175	T2PAK
YJD212080NCTG1	1200V	77 mΩ	Gen1	38A	41	58	220	0.68	175	TO-247AB
YJD212080NCFG1	1200V	77 mΩ	Gen1	39A	41	58	223	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7G1	1200V	77 mΩ	Gen1	30A	41	58	135	1.1	175	TO263-7L
YJD212080NCTGH	1200V	80 mΩ	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247AB
YJD212080NCFGH	1200V	80 mΩ	GH	33A	131	85	224	0.67	175	TO-247-4L
YJD212080B7GH	1200V	80 mΩ	GH	30A	131	85	136	1.1	175	TO-263-7L
YJD212080T2GH	1200V	80 mΩ	GH	34	131	85	234	0.64	175	T2PAK
YJD2120120NCTGH	1200V	120 mΩ	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2120120NCFGH	1200V	120 mΩ	GH	24A	67	56	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2120120BGH	1200V	120 mΩ	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	D2PAK
YJD2120120B7GH	1200V	120 mΩ	GH	24.5A	67	56	166	0.85	175	TO-263-7L
YJD2120160NCFG1	1200V	160 mΩ	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247-4L
YJD2120160NCTG1	1200V	160 mΩ	Gen1	21A	39	47	157	0.95	175	TO-247AB
YJD2120240NCTGHQ	1200V	240 mΩ	GH	13.5A	47	36	105	1.42	175	TO-247AB
YJD2120240NCFGHQ	1200V	240 mΩ	GH	13.5A	47	36	105	1.42	175	TO-247-4L
YJD2120240BGHQ	1200V	240 mΩ	GH	13.5A	47	36	105	0.93	175	D2PAK
YJD2120240B7GHQ	1200V	240 mΩ	GH	13.5A	47	36	105	0.93	175	TO-263-7L
YJD206520NCTGH	650V	20 mΩ	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206520NCFGH	650V	20 mΩ	GH	107A	287	359	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525NCTGH	650V	25 mΩ	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247AB
YJD206525NCFGH	650V	25 mΩ	GH	107A	275	358	375	0.4	175	TO-247-4L
YJD206525T2GH	650V	25 mΩ	GH	112	275	358	395	0.38	175	T2PAK
YJD206530NCFG1	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247AB
YJD206530NCTG1	650V	30 mΩ	Gen1	65A	101	185	260	0.48	175	TO-247-4L
YJD206550NCTGH	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206550NCFGH	650V	50 mΩ	GH	60A	121	208	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206550B7GH	650V	50 mΩ	GH	57A	121	208	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD206560NCTGH	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247AB
YJD206560NCFGH	650V	60 mΩ	GH	60A	116	205	250	0.6	175	TO-247-4L
YJD206560B7GH	650V	60 mΩ	GH	57A	116	205	223	0.67	175	TO-263-7L
YJD2065100NCTGH	650V	100 mΩ	GH	32A	66	105	166	0.9	175	TO-247AB
YJD2065100NCFGH	650V	100 mΩ	GH	32A	66	105	166	0.9	175	TO-247-4L
YJD2065100B7GH	650V	100 mΩ	GH	35A	66	105	200	0.75	175	TO-263-7L
YJD2065200NCTGH	650V	200 mΩ	GH	16A	43	67	89	1.4	175	TO-247AB
YJD2065200NCFGH	650V	200 mΩ	GH	16A	43	67	89	1.4	175	TO-247-4L
YJD2065200BGH	650V	200 mΩ	GH	19A	43	67	120	1.25	175	D2PAK
YJD2065200B7GH	650V	200 mΩ	GH	19A	43	67	120	1.25	175	TO-263-7L
YJD217045NCTGH	1700V	45 mΩ	GH	55A	304	145	375	0.4	175	TO-247AB
YJD217045NCFGH	1700V	45 mΩ	GH	55A	304	145	375	0.4	175	TO-247-4L

公司实验室平台
Company Laboratory Platform

公司已按照国内一流电子实验室标准建设了 5000 平米，功能布局涵盖电性测试实验室、可靠性实验室、失效分析实验室以及模拟应用实验室等为一体的研发中心实验基地，已获得国家 CNAS 认证实验室，集中打造一站式产品实验应用平台。



可靠性试验室

遵循AEC-Q101、Mil-Std-750、JEDEC的可靠性试验标准。
YJ的实验室可以完成半导体分立器件所有的试验项目。



失效分析实验室

完整且闭环的失效分析以及改善流程，精准定位产品失效原因，及时反馈客户。

实验室平台

电性测试实验室

设备齐全，对产品进行全方位测量，为客户提供真实且准确的产品数据。



模拟应用实验室

通过专用设备仪器给产品做负载实验，模拟产品在客户端使用场景，确保产品特性符合客户需求。



长期可靠性试验测试参考表
LONG TERM RELIABILITY TEST REFER

序号	试验项目 Test Item	试验条件 Condition	参考标准 Reference	实验时间 (Time)
1☆	预处理 (Pre-conditioning)	Performed on surface mount devices (SMDs) prior to RSH,TC,AC, H3TRB & IOL/PTC stresses only.	JESD22A-113	1.Temperature Cycling:-40℃~60℃, 5cycles; 2.Bake:125℃,24H; 3.Moisture Soak:85±2℃, 85±5%/168h; 4.Reflow*3cycles:260℃,3cycles time 5-60min
2☆	高温反偏 (High Temperature Reverse Bias)	Tjmax,80%VR(TVS 100%VRwm、稳压管 80%Vzmin)	MILSTD750-1 method M1038A	1000Hrs
3	间歇老化 (Intermittent Operational Life)	△Tj≥100℃,2min ON/2min OFF	MIL-STD-750 Method 1037	15000Cycles
4☆	高温高湿反偏 (High-temperature High-humidity Reverse Bias)	85±2℃, 85%±5%RH, 80%VR (TVS 100%VRwm、稳压管 80%Vzmin)(Max=100V)	JESD22-A101	1000Hrs
4☆ alt	高加速寿命实验 (Highly Accelerated Stress Test)	85±2℃, 85%±5%RH, 80%VR (TVS 100%VRwm、稳压管 80%Vzmin)(Max=100V)	JESD22-A110	96Hrs OR 264Hrs
5☆	高温高湿 (High-temperature High-humidity storage test)	85±2℃, 85±5%RH	MIL-STD-202F METHOD-103B	1000Hrs
6☆	温度循环试验 (Temperature Cycling)	150℃ (+15, -0) /15min, -55℃ (+0, -10) /15min	JESD22-A104	1000 cycles
7	高温储存 (High Temperature Storage)	150℃ (+10, -0)	JESD22-A103	1000Hrs
8	低温储存 (Low Temperature storage)	-55℃	Specification	1000H
9	无偏置高加速寿命试验 (Unbiased Highly Accelerated Stress Test)	130℃, 85℃%RH	JESD22 A-118	96Hrs
9al	高压蒸煮 (Auto-clave)	121℃±2℃,15 psig,100%RH	JESD22-A102	96Hrs
10☆	易焊性试验 (Solderability)	235℃±5℃	J-STD-002	3'
11☆	耐焊接热 (Resistance to solder heat)	DIP: 270±5℃ SMD: 260℃ (+5,-0)	JESD22-B106 JESD22-A111	DIP: 7sec(+2, -0) SMD :10s
12	弯曲牢度 (Bending Strength)	φ0.6mm~0.78mm W=0.5Kg >φ1.20mm W=2Kg	MIL-STD-750 Method 2036	3Times
13	终端牢度 (Terminal Strength)	φ0.6mm~0.78mm W=1Kg >φ1.20mm W=3Kg	MIL-STD-750 Method 2036	15s
14	正向浪涌试验 (Forward Surge Test)	8.3ms,Single,Half-Wave	MIL-STD-750 Method 4066	5Times
15	盐雾试验 (Salt Spray Test)	试验温度: 35±2℃, 氯化钠盐水浓度: 5±0.1%, PH值范围: 6.5-7.2, 沉降率: 1~2ml/80cm².h	GB/T 2423.17-2008	24H
16	静电测试 (ESD)	HBM: 100pF,1500Ω	AEC-Q101-001/002	3cycle
17☆	高温Gate偏压 (High Temperature Gate Bias)	Tjmax,100%Vgs (前500H加+方向电压, 后500H加-方向电压)	JESD22-A-108	1000Hrs
18☆	稳态寿命试验 (Steady State Operational)	Ta=25±5℃, PD=Max (Izm= PD/VZ)	MIL-STD-750-1 M1038 Condition B (Zeners)	1000Hrs

长期可靠性试验测试参考表-车用
LONG TERM RELIABILITY TEST REFER –AUTOMOTIVE

序号	试验项目 Test Item	试验条件 Condition	参考标准 Reference	实验时间 (Time)
1	应力试验前后电性能测试 (Pre- and Post-Stress Electrical Test)	For specification	Device specification	/
2☆	预处理 (Pre-conditioning)	Performed on surface mount devices (SMDs) prior to RSH,TC,AC, H3TRB & IOL stresses only.	JESD22A-113	1.Temperature Cycling:-40℃~60℃, 5cycles; 2.Bake:125℃,24H; 3.Moisture Soak:85±2℃, 85±5%/168h; 4.Reflow*3cycles:260℃,3cycles time 5-60min
3	外观检查 (External Visual)	Device construction, marking, and workmanship	JEDS22 B101	/
4	参数验证 (Parametric Verification)	Tested to device specification requirements	Device specification	/
5☆	高温反偏 (High Temperature Reverse Bias)	Tj= max, V=100% rated V	MILSTD750-1 method M1038A	1000Hrs
5C☆	稳态寿命试验 (Steady State Operational)	Ta=25±5℃, PD=Max (Izm= PD/VZ)	MIL-STD-750-1 M1038 Condition B (Zeners)	1000Hrs
6	高温栅极偏压 (High Temperature Gate Bias)	Tjmax,100%Vgs (+/-) 方向加电两组试验, 每组一个方 向1000H	JESD22-A-108	1000Hrs
7☆	温度循环试验 (Temperature Cycling)	150℃ (+15, -0) /15min, -55℃ (+0, -10) /15min	JESD22 A104; Q101 appendix 6	1000 cycles
8 *2	无偏置高加速寿命试验 (Unbiased Highly Accelerated Stress Test)	130℃, 85%RH	JESD22 A-118	96Hrs
8 *2 alt	高压蒸煮 (Auto-clave)	121℃±2℃, 15 psig, 100%RH	JESD22-A102	96Hrs
9☆	高加速寿命实验 (Highly Accelerated Stress Test)	130±2℃, 85%±5%RH,OR 110±2℃, 85%±5%RH 80%VR (TVS 100%VRwm、稳压管 80%Vzmin) (Max=42V)	JESD22-A110	96Hrs OR 264Hrs
9☆ alt	高温高湿反偏 (High-temperature High-humidity Reverse Bias)	85±2℃, 85%±5%RH, 80%VR (TVS 100%VRwm、稳压管 80%Vzmin) (Max=100V)	JESD22-A101	1000Hrs
10	间歇老化 (Intermittent Operational Life)	△Tj≥100℃,2min ON/2min OFF	MIL-STD-750 Method 1037	15000Cycles
11a	静电测试 (ESD)	HBM: 100pF,1500Ω ,GPP:4KV; Others:2KV;	AEC-Q101-001	/
11b	静电测试 (ESD)	CDM: 500V	AEC-Q101-005	/
12	物理破坏性分 (DPA)	Choose 2 pcs for DPA after H3TRB or HAST and TC respectively	AEC-Q101-004 Section 4	/
13	外形尺寸 (Physical Dimension)	Verify physical dimensions to specifications	JESD22 B100	/
14	终端牢度 (Terminal Strength)	φ0.6mm~φ0.78mm W=1Kg >φ1.20mm W=3Kg	MIL-STD-750 Method 2036	15s
15☆	耐焊接热 (Resistance to solder heat)	DIP: 270±5℃ SMD: 260℃ (+5,-0)	JESD22-B106 JESD22-A111	DIP: 7s(+2, -0) SMD :10s
16☆	易焊性试验 (Solderability)	245℃±5℃	J-STD-002, JESD22 B102	5±0.5s
17	热阻测试 (Thermal Resistance)	Pre & post process change	JESD-24-3, 24-4, 24-6 as appropriate	/

全球布局
Global Layout

随着经营规模的持续扩大，公司逐步迈向集团化、国际化。集团已布局全球智能工厂和研发中心合计超 20 家，并设立办事处超 30 个，品牌影响力不断提升。



为全球客户提供一站式产品、 技术、 服务解决方案

联系我们
CONTACT US
联系我们

营销一部

地址：深圳市宝安区西乡大道 230 号
满京华艺峦大厦 1 座 16 楼
座机：0086-755-61200115
手机：0086-13828787610
邮箱：changhao.li@21yangjie.com

营销二部

地址：上海市虹桥商务区申虹路 666 号
正荣中心 1 号楼 503
座机：0086-21-64661571
手机：0086-15805277362
邮箱：lisa.wang@21yangjie.com

杭州办事处

地址：杭州市滨江区长河街道科技馆街
1600 号银泰国际商务中心 2706 室
座机：0086-571-87552171
手机：0086-13801454558
邮箱：mj@21yangjie.com

台湾办事处

地址：新北市中和区建八路 16 号六楼 -5
座机：886-2-82263996
手机：886-928245366
邮箱：stanley.yeh@21yangjie.com

Department of International Trade

Add.: No.6,West Heye Road,
Hanjiang District Yangzhou China
Tel: 0086-514-80983686
Mobile: 0086-18852700506
E-mail: yjsale7@21yangjie.com

大客户部

地址：中国扬州市邗江区荷叶西路 6 号
座机：0086-514-80980345
手机：0086-15901703556
邮箱：jin.ji@21yangjie.com

光伏业务部

地址：中国扬州市邗江区荷叶西路 6 号
座机：0086-514-80982898
手机：0086-13805278332
邮箱：zgj@21yangjie.com

晶圆业务部

地址：扬州市邗江区开发区创业园中路 26 号
座机：0086-514-80982389
手机：0086-15952735218
邮箱：lei.shen@21yangjie.com